

Germanium PNP Transistor

GF181

25V / 10mA


DATASHEET

OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72


GF 181

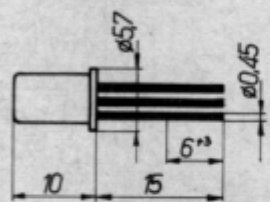
Nicht für Neuentwicklung



Germanium - pnp - Legierungs - Diffusions - Transistor der Bauform A 4/15 - 4b nach TGL 11 811 für UKW-Mischstufen.

Schirm





Masse ca. 0,6 g


Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 25 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 20 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 0,5 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 50 mW
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 10 mA
Emitterstrom	I_{EL}	= 11 mA
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 1 mA
Sperrschichttemperatur	θ_{JL}	= 75 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= 65 °C
Wärmewiderstand	R_{thja}	= 0,6 grd/mW

8.69

76

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)



RFT electronic		GF 181 Nicht für Neuentwicklung		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -U _{CB} = 6 V	-I _{CB0}		2 μA	7,5 μA
Kollektor-Basis-Reststrom -U _{CB} = 25 V	-I _{CB0}			100 μA
Emitter-Basis-Reststrom -U _{EB} = 0,5 V	-I _{EB0}			100 μA
Dynamische Kennwerte				
Kurzschlußstromverstärkung -U _{CE} = 6 V -I _C = 1 mA	h _{21E}	40		
Oszillatorspannung -U _{CB} = 7 V -I _C = 1,5 mA f = 100 MHz	U _{OSZ}	140 mV		300 mV
Oszillatorspannung -U _{CB} = 5,5 V -I _C = 0,9 mA f = 100 MHz	U _{OSZ}	120 mV		
Vierpolparameter	g _{11b}		21 mS	
	-b _{11b}		10 mS	
-U _{CB} = 6 V	C _{11b}		14,4 pF	
-I _C = 1,5 mA	y _{12b}		0,29 mS	
f = 100 MHz	-φ _{12b}		130 °C	
	y _{21b}		13 mS	
	φ _{21b}		110 °C	
	g _{22b}		0,37 mS	
	b _{22b}		1,5 mS	
	C _{22b}		2,5 pF	
Bestellbeispiel für einen Transistor		Transistor GF 181		
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Stammtrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)		3.69 77		

